СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхема интегральная 164ИР10 ВК соответствует техническим условиям АЕЯР.431200.203-10 ТУ; ОСМ164ИР10 ВК - АЕЯР.431200.203-10 ТУ и ПО.070.052 и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по извещению №_____от_____
Дата

Штамп ОТК Штамп представителя заказчика

Перепроверка произведена_____
Дата

Приняты по извещению №_____от_____
Дата

Штамп ОТК Штамп представителя заказчика

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

«ВНИМАНИЕ – Соблюдайте меры предосторожности при работе – ПРИБОРЫ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К СТАТИЧЕСКОМУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ»

Допустимое значение статического потенциала 200 В.

МИКРОСХЕМЫ 164ИР10 ВК, ОСМ164ИР10 ВК

Код ОКП : 6331334255

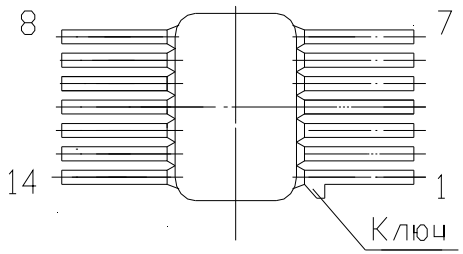
ЭТИКЕТКА

ЛСАР.431230.035 ЭТ

Микросхемы интегральные 164ИР10 ВК, ОСМ164ИР10 ВК – восемнадцатиразрядный регистр сдвига 10.

Шифр кода маркировки микросхемы 164ИР10 ВК –2КИР10 в соответствии с АЕЯР.431200.203 ТУ; ОСМ164ИР10 ВК – ОСМ2КИР10 в соответствии с АЕЯР.431200.203 ТУ и ПО.070.052.

Схема расположения выводов



Нумерация выводов показана условно.
Ключ показывает начало отсчета выводов.
Масса не более 1,0 г.

Таблица назначения выводов

Обозначение выводов	Назначение выводов	Обозначение выводов	Назначение выводов
1	Вход D1	8	Выход Q5
2	Свободный	9	Выход Q6
3	Вход C	10	Выход Q4
4	Вход D2	11	Выход Q2
5	Вход D3	12	Выход Q3
6	Вход D4	13	Выход Q1
7	Общий GND	14	Питание U_{CC}

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

при температуре (25 ± 10)º С

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
В Выходное напряжение низкого уровня, В, при: U_{CC}=9,9В; U_{IL}=1,9 В; R_L=150кОм	U_{OL}	-	0,5
Выходное напряжение высокого уровня, В, в при: U_{CC}=8,1В; R_L=150кОм; U_{IH} = 6,3 В	U_{OH}	7,7	-
Входной ток низкого уровня, мкА, при: U_{CC}=9,9 В; U_{IL}=0	I_{IL}	-0,2	-
Входной ток высокого уровня,мкА, при:U_{CC}=9,9 В; U_{IH} = 9,9 В	I_{IH}	-	0,2
Ток потребления выходного напряжения низкого уровня, мкА, при: U_{CC}=9,9 В; U_{IL} =0	I_{CCL}	-	10
Ток потребления выходного напряжения высокого уровня, мкА, при: U_{CC}=9,9 В; U_{IH} =9,9 В	I_{CCH}	-	10
Частота следования импульсов тактовых сигналов, мГц, при: U_{CC}=9,0 В; Q = 2; C_H = 15 пФ	f_C	2,5	-
Динамический ток потребления, мА, (параметры входного сигнала), при: U_{CC}=9,0 В; f_C =100 кГц; C_H =15 пФ	I_{OCC}	-	3,0

Драгоценных металлов не содержится.
Цветных металлов не содержится

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка ($T_{нм}$) микросхемы в режимах и условиях, допускаемых ТУ, 100000 ч, а в следующих облегченных режимах

при: U_{CC}=9 В минус 10% и C_L не более 25 пФ – 120000 ч.

Гамма-процентный ресурс ($T_{p\gamma}$) микросхемы при γ = 95% 200000 ч.

Минимальный срок сохраняемости микросхемы ($T_{см}$) при ее хранении:

- в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемыми влажностью и температурой или местах хранения микросхем, вмонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП - 25 лет;
- в неотапливаемом хранилище – 16,5 лет;
- под навесом и на открытой площадке, вмонтированными в аппаратуру (в составе незащищенного объекта), или в комплекте ЗИП – 12,5 лет.

Срок сохраняемости исчисляется с даты изготовления, указанной на микросхеме.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых микросхем всем требованиям АЕЯР.431200.203-10 ТУ, а микросхем с индексом

«ОСМ» - АЕЯР.431200.203-10 ТУ и ПО.070.052 в течение срока сохраняемости и минимальной наработки в пределах срока сохраняемости при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и эксплуатации, а также указаний по применению, установленных ТУ.

Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхеме.